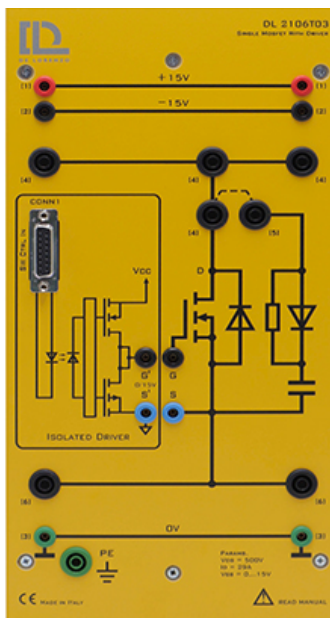


# DL 2106T03



## MOSFET con driver

MOS di potenza a canale N in modalità di accumulazione con diodo integrato utilizzato come interruttore molto veloce nei convertitori di potenza switching. Un soppressore RCD è opzionale per ammorbidire la dinamica del MOSFET. Il MOSFET può essere pilotato direttamente o digitalmente da un gate driver isolato. Per attivare il driver è necessaria un'alimentazione  $\pm 15V$ .

### Caratteristiche tecniche:

#### MOSFET

Tensione drain-source:  $U_{DS} = 500 V$

Corrente continua di drain:  $I_D = 29 A$

Resistenza drain-source in stato on:  $R_{DS(on)} = 0,13 \Omega$

Tensione gate-source:  $U_{GS} = \pm 15 V$

#### Stabilizzatore RCD

R:  $1 k\Omega / 2W$

C:  $10 nF / 250 V_{ca}, 630 V_{dc}$

#### Gate driver

Segnale di ingresso:  $0 / 3,3V, 0 / 5V$

Segnale di uscita:  $0 / 15V$

## single MOSFET with driver

N-channel enhancement mode power MOS with integrated body diode used as very fast switch in switching power converters. An RCD snubber is optional to soften the dynamics of the MOSFET. The MOSFET can be driven directly or by an isolated gate driver digitally. To active the driver, a  $\pm 15V$  power supply is required.

### Technical features:

#### MOSFET

Drain-source voltage:  $U_{DS} = 500 V$

Continuous drain current:  $I_D = 29 A$

Drain-source on-state resistance:  $R_{DS(on)} = 0.13 \Omega$

Gate-source voltage:  $U_{GS} = \pm 15 V$

#### RCD snubber

R:  $1 k\Omega / 2W$

C:  $10 nF / 250 V_{ac}, 630 V_{dc}$

#### Gate driver

Input signal:  $0 / 3.3V, 0 / 5V$

Output signal:  $0 / 15V$

### MOSFET simple con controlador

MOS de potencia de modo de mejora de canal N con diodo integrado utilizado como interruptor muy rápido en convertidores de potencia de conmutación. Un amortiguador RCD es opcional para suavizar la dinámica del MOSFET. El MOSFET se puede accionar directamente o mediante un controlador de puerta aislado digitalmente. Para activar el controlador, se necesita una fuente de alimentación de  $\pm 15V$ .

#### Características técnicas:

##### MOSFET

Tensión de la fuente de drenaje:  $U_{DS} = 500 V$ .

Corriente de drenaje continua:  $I_D = 29 A$ .

Resistencia en estado de encendido de la fuente de drenaje:  $R_{DS}(\text{encendido}) = 0.13 \Omega$

Tensión de la fuente del punto de inyección:  $U_{GS} = \pm 15 V$ .

##### Amortiguador RCD

R: 1 kW / 2W

C: 10 nF / 250 Vac, 630 Vcc

##### Controlador de compuerta

Señal de entrada: 0 / 3.3V, 0 / 5V.

Señal de salida: 0 / 15V

### MOSFET simple avec pilote

MOS de puissance en mode d'enrichissement à canal N avec diode de corps intégrée utilisée comme commutateur très rapide dans les convertisseurs de puissance à découpage. Un amortisseur RCD est facultatif pour adoucir la dynamique du MOSFET. Le MOSFET peut être piloté directement ou numériquement par un driver de grille isolé. Pour activer le driver, une alimentation  $\pm 15V$  est nécessaire.

#### Caractéristiques techniques:

##### MOSFET

Tension drain-source :  $U_{DS} = 500 V$

Courant de drain continu :  $I_D = 29 A$

Résistance drain-source à l'état passant :  $R_{DS}(\text{on}) = 0,13 \Omega$

Tension grille-source :  $U_{GS} = \pm 15 V$

##### Amortisseur RCD

R : 1 kW / 2 W

C : 10 nF / 250 Vca, 630 Vcc

##### Driver de la Grille

Signal d'entrée : 0 / 3,3 V, 0 / 5 V

Signal de sortie : 0 / 15V